



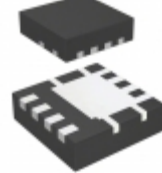





	<h2 style="color: #E67E22;">DMN6069SE-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN6069SE-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFETN-CH 60VSOT223
Datenblätter:	 DMN6069SE-13.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 27738 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN6069SE-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFETN-CH 60VSOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27738 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 4.3A (Ta), 10A (Tc) 2.2W (Ta) Surface
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Ta), 10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	69 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	825pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	DMN6069SE-13DITR

DMN6069SE-13 ist neu im Original, Suche DMN6069SE-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN6069SE-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN6069SE-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN6068SE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT223</p>	 <p>DMN6069SE-13 DIODES DIODES SOT-223</p>	 <p>DMN6069SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 5.6A POWERDI333</p>	 <p>DMN6069SE DIODES DMN6069SE DIODES</p>
 <p>DMN6069SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 5.6A POWERDI333</p>	 <p>DMN6070SFCL-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 3A 6-DFN</p>	 <p>DMN6069SFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333</p>	 <p>DMN6069SFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 18A POWERDI3333</p>

heiße Teile

Mehr

DMN601WKQ-7	DMN6040SFDE-7	DMN6040SK3	DMN6040SK3-13	DMN6040SK3-13
DMN6040SSD	DMN6040SSD-13	DMN6040SSDQ	DMN6040SSDQ-13	DMN6040SSS
DMN6040SSS-13	DMN6040SVT-7	DMN6040SVTQ	DMN6040SVTQ-7	DMN6066SSD
DMN6066SSD-13	DMN6066SSDQ-13	DMN6066SSS	DMN6066SSS-13	DMN6066SSSQ-13
DMN6068LK3	DMN6068LK3-13	DMN6068SE	DMN6068SE-13	DMN6069SE
DMN6069SE-13	DMN6070SFCL-7	DMN6070SSD	DMN6070SSD-13	DMN6070SY-13
DMN6075S-7	DMN6075SD-7	DMN60H080DS-7	DMN6140L-13	DMN6140L-7
DMN6140LQ	DMN6140LQ-7	DMN61D8L	DMN61D8L-7	DMN61D8LQ
DMN61D8LQ-7	DMN61D8LVT	DMN61D8LVT-7	DMN61D8LVTQ	DMN61D8LVTQ-7
DMN61D9U	DMN61D9U-7	DMN61D9UDW	DMN61D9UDW-7	DMN61D9UW

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

